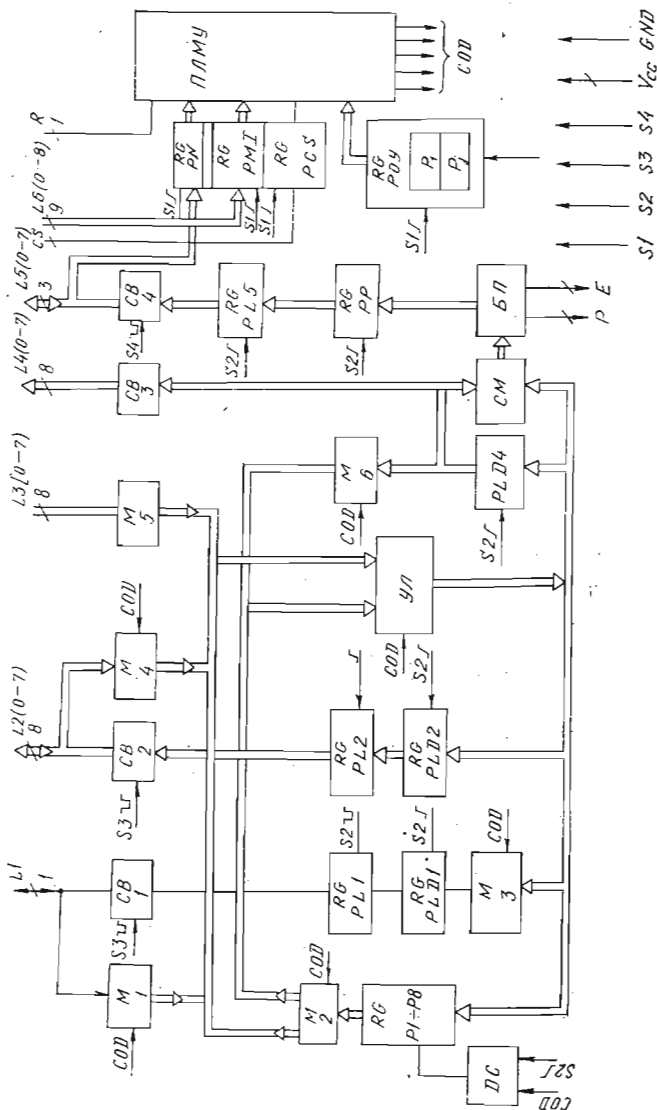


СТРУКТУРНАЯ СХЕМА



Принятые сокращения в схеме

- |  |   |
|--|---|
| <i>L1</i> — двунаправленная битовая магистраль         | <i>P</i> и <i>E</i> — выходы признаков                      |
| <i>L2</i> — восьмиразрядная двунаправленная магистраль | <i>R</i> — вход опроса схемы приоритета                     |
| <i>L3</i> — входная восьмиразрядная магистраль         | <i>M</i> — мультиплексер                                    |
| <i>L4</i> — выходная восьмиразрядная магистраль        | <i>CB</i> — схема вывода                                    |
| <i>L5</i> — двунаправленная трехразрядная магистраль   | <i>RG P1—P8</i> — регистры общие                            |
| <i>L6</i> — девятиразрядная входная магистраль         | <i>RG PLD</i> — регистры магистрали                         |
| <i>S1—S4</i> — управляющие синхросигналы               | <i>RG PL</i> — регистры буферные                            |
| <i>MK</i> — микрокоманда                               | <i>УЛ</i> — устройство логическое                           |
| <i>СОД</i> — код операции                              | <i>RG PP</i> — регистр приоритета                           |
| <i>CS</i> — выборка кристалла                          | <i>RG PM</i> — регистр микрокоманд                          |
|  | <i>RG PCS</i> — регистр выборки кристалла                   |
|  | <i>RG ПОУ</i> — регистр остаточного управления              |
|  | <i>ПЛМУ</i> — программируемая логическая матрица управления |
|  | <i>БП</i> — блок приоритета                                 |
|  | <i>СМ</i> — схема маскирования                              |

Назначение выводов

- |                              |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1— вход <i>S1</i>            | 17— вход <i>L6</i> [3]       | 33— вход <i>L3</i> [5]       |
| 2— вход <i>S2</i>            | 18— вход <i>L6</i> [5]       | 34— выход <i>L4</i> [5]      |
| 3— вход <i>S3</i>            | 19— вход <i>L6</i> [6]       | 35— вход/выход <i>L2</i> [5] |
| 4— вход <i>S4</i>            | 20— вход <i>L6</i> [8]       | 36— вход <i>L3</i> [6]       |
| 5— вход/выход <i>L2</i> [∅]  | 21— вход <i>L6</i> [7]       | 37— выход <i>L4</i> [6]      |
| 6— выход <i>L4</i> [∅]       | 22— вход <i>CS</i>           | 38— вход/выход <i>L2</i> [6] |
| 7— вход <i>L3</i> [∅]        | 23— вход <i>R</i>            | 39— вход <i>L3</i> [7]       |
| 8— вход/выход <i>L2</i> [1]  | 24— земля                    | 40— выход <i>L4</i> [7]      |
| 9— выход <i>L4</i> [1]       | 25— +5 В                     | 41— вход/выход <i>L2</i> [7] |
| 10— вход <i>L3</i> [1]       | 26— вход <i>L6</i> [2]       | 42— выход <i>E</i>           |
| 11— вход/выход <i>L2</i> [2] | 27— вход <i>L6</i> [1]       | 43— выход <i>P</i>           |
| 12— выход <i>L4</i> [2]      | 28— вход <i>L6</i> [∅]       | 44— вход/выход <i>L5</i> [∅] |
| 13— вход <i>L3</i> [2]       | 29— вход <i>L6</i> [4]       | 45— вход/выход <i>L5</i> [1] |
| 14— вход/выход <i>L2</i> [3] | 30— вход <i>L3</i> [4]       | 46— вход/выход <i>L5</i> [2] |
| 15— выход <i>L4</i> [3]      | 31— выход <i>L4</i> [4]      | 47— вход/выход <i>L1</i>     |
| 16— вход <i>L3</i> [3]       | 32— вход/выход <i>L2</i> [4] | 48— +5 В                     |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре 25±5° С)

- |   |                  |
|---|------------------|
| Напряжение питания . . . . .                                  | +5 В ±5%         |
| Выходной ток низкого уровня:                                  |                  |
| по выходам <i>L4</i> , <i>P</i> , <i>E</i> . . . . .          | не более 0,05 мА |
| по входам/выходам <i>L1</i> , <i>L2</i> , <i>L5</i> . . . . . | не более 0,45 мА |

583ВМ1А  
583ВМ1Б

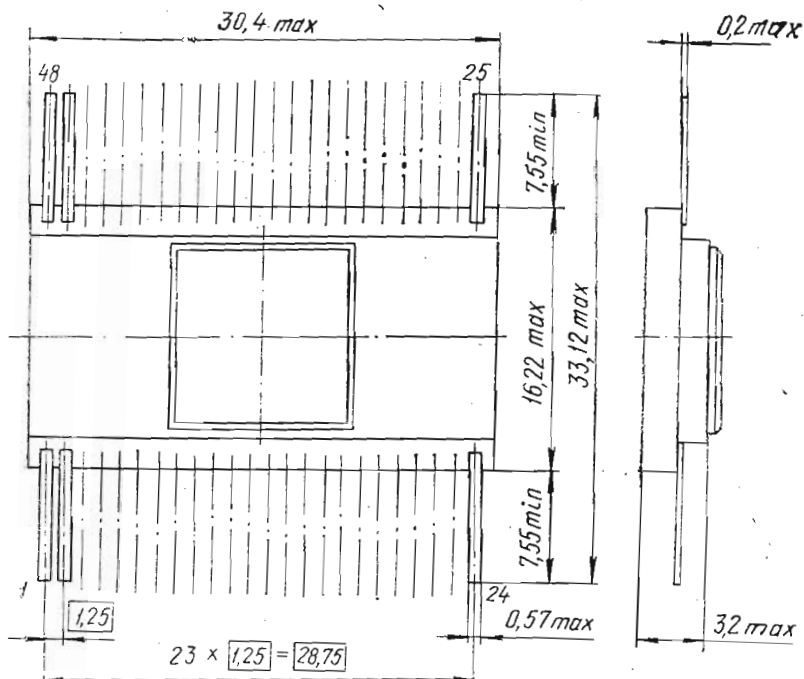
МИКРОПРОЦЕССОР ЛОГИЧЕСКИЙ

Напряжение инжектора . . . . .	от 1,0 до 1,4 В
Выходное напряжение высокого уровня . . . . .	не более 0,4 В
Помехоустойчивость . . . . .	не менее 0,4 В
Время цикла . . . . .	не более 1 мкс
Время задержки распространения при включении (выключении):	
по входу $S3$ — выходам $L1, L2, L5$ . . . . .	не более 150 нс
по входу $L1, L2, L3$ — выходам $P, E$ . . . . .	не более 300 нс
по входу $R$ — выходам $P, E$ . . . . .	не более 250 нс
по входу $S2$ — выходам $L1, L2, L5$ для микро- схем:	
583ВМ1А . . . . .	не более 250 нс
583ВМ1Б . . . . .	не более 350 нс
по входу $S1$ — выходам $P, E$ для микросхем:	
583ВМ1А . . . . .	не более 400 нс
583ВМ1Б . . . . .	не более 500 нс
по входу $S2$ — выходу $L4$ для микросхем:	
583ВМ1А . . . . .	не более 250 нс
583ВМ1Б . . . . .	не более 350 нс

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

Максимальное напряжение на входе микросхемы	5,5 В
Минимальное отрицательное напряжение на входе микросхемы . . . . .	0,4 В
Максимальный ток инжектора . . . . .	500 мА
Максимальное напряжение на выходе закрытой схемы . . . . .	6,0 В
Минимальное отрицательное напряжение на выхо- де микросхемы . . . . .	0,3 В
Максимальная длительность фронта и среза вход- ного сигнала . . . . .	300 нс
Максимальная суммарная емкость нагрузки . . .	200 пФ

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ  
ОСТАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ



Масса — не более 4,5 г

Смещение осей выводов от номинального расположения не более 0,1 мм (допуск зависимый).

Нумерация выводов микросхемы показана условно.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Вибрация:

диапазон частот . . . . . от 1 до 5000 Гц  
ускорение . . . . . до 40 g

Многokратные удары:

ускорение . . . . . до 150 g  
длительность удара . . . . . от 1 до 3 мс

Одиночные удары:	
ускорение . . . . .	до 1000 g
длительность удара . . . . .	от 0,2 до 1,0 мс
Линейные нагрузки:	
ускорение . . . . .	до 500 g
Температура окружающей среды . . . . .	от минус 60 до +125° С
Многokrатные циклические изменения температуры . . . . .	от минус 60 до +125° С
Атмосферное давление . . . . .	от 5 мм рт. ст. до 3 атм

Иней, роса.  
Соляной туман.  
Среда, зараженная плесневыми грибами.

#### НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка <sup>○</sup> . . . . .	50 000 ч
Срок сохраняемости <sup>○</sup> . . . . .	25 лет

#### УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 073.041—80 и требованиями, изложенными ниже.

Допустимое значение статического потенциала 100 В.

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхемы в контактирующих устройствах замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

<sup>○</sup> В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.